01;02

Сечения одно- и двукратной ионизации атомов гелия ударом быстрого высокозарядного иона

© А.Б. Войткив

Институт электроники АН Узбекистана, 700143 Ташкент, Узбекистан

(Поступило в Редакцию 5 июня 1996 г. В окончательной редакции 31 января 1997 г.)

Получены формулы для сечения одно- и двукратной ионизации атомов гелия при столкновениях с быстрыми высокозарядными ионами в области параметров столкновения $v^2 \gg Z \gtrsim v$, $v_0 \ll v < c$, где Z, v - cоответственно заряд и скорость иона, $v_0 - x$ арактерная скорость электронов в основном состоянии атома гелия, c - cкорость света.

Введение

Различные аспекты столкновений быстрых высокозарядных ионов (ВЗИ) с атомами гелия обсуждались в значительном количестве работ [1-13]. В ряде экспериментов [2-5] исследовалась одно- и двукратная ионизация гелия быстрыми ВЗИ в области параметров задачи: $Z \gtrsim v \gg v_0, v^2/c^2 \ll 1$ (Z, v — заряд и скорость ВЗИ, v0 — характерная скорость электронов в основном состоянии атома, *c* = 137 — скорость света; здесь и ниже, если не оговорено иное, используются атомные единицы). Для расчета сечений ионизации гелия в столкновениях при Z $\gtrsim v \gg v_0$, когда неприменимо борновское приближение, имеется ряд подходов [4,6-13], которые выходят за рамки первого порядка теории возмущений по взаимодействию с полем ВЗИ и дают разумное согласие с экспериментальными данными по сечениям ионизации гелия. Поскольку, однако, эти подходы в противоположность бете-борновскому (см., например, [14]), как правило, не приводят к простым конечным формулам для сечений, то для описания результатов экспериментов довольно широко [3,5,15] используются эмпирические скейлинги. Кроме того, реальные расчеты сечений ограничиваются обычно областью относительно небольших значений зарядов быстрых ионов.

В эксперименте [15] (см., также [2,5]) рассматривалась ионизация атомов гелия ионами урана U⁹⁰⁺, скорости которых уже приближаются к релятивистским (вплоть до v/c = 0.72). В то же время заряды этих ионов настолько велики, что выполняется соотношение $Z \sim v \sim c$.

В данном разделе мы рассмотрим столкновения быстрых (в том числе и релятивистских) ВЗИ с атомами гелия при $v^2 \gg Z \gtrsim v$, $v_0 \ll v \ll c$ и получим для сечений одно- и двукратной ионизации гелия простые формулы, которые описывают все известные нам экспериментальные данные в рассматриваемой области параметров задачи. Отметим, что, несмотря на большие значения скоростей столкновения, рассматриваемые в данной работе, эти столкновения нельзя отнести к так называемому "пределу высоких скоростей", когда необходимо выполнение не только условия $v \gg v_0$, но и $Z \ll v$ (см., например, [16]).

Основные соотношения

При теоретическом описании ионизации гелия в столкновениях с быстрыми ВЗИ возникают две основные трудности: а) влияние поля быстрого ВЗИ на атомные электроны следует учитывать, вообще говоря, вне рамок теории возмущений; b) необходимо с достаточной точностью описывать двухэлектронные состояния атома гелия. Однако эти трудности, по-вимому, в значительной степени "конкурируют" друг с другом. Именно точный учет межэлектронного взаимодействия наиболее важен в пределе больших скоростей столкновения (особенно при расчете сечений двухэлектронной ионизации), когда Z « v и влияние поля быстрой частицы можно учитывать в рамках теории возмущений. С другой стороны, когда заряд иона очень высок, относительная роль электронных корреляций уменьшается. Известно (см., например, [17]), что в этом случае основным механизмом ионизации атома является так называемый прямой, когда процесс ионизации можно описывать в приближении назависимых электронов, которое мы и будем использовать ниже для нахождения сечений ионизации гелия при $Z \gtrsim v \gg v_0$. В рамках этого приближения вероятность *W_n* одновременного отрыва *n* электронов из атомной оболочки, содержащей N электронов, определяется следующим выражением [17]:

$$W_n(b) = \left(\frac{N}{n}\right) w^n (1-w)^{N-n}, \qquad (1)$$

где w(b) — вероятность одноэлектронного (ионизационного) перехода, b — прицельный параметр, $\left(\frac{N}{n}\right)$ — биномиальные коэффициенты.

При вычислении w(b) считается, что электрон в атоме движется в некотором усредненном поле. Следуя [11], будем рассматривать вероятность w(b) как зависящую от зарядового состояния иона отдачи $w = w_n(b)$. Тогда для сечений одно- и двукратной ионизации гелия имеем

$$\sigma_i^{(1+)} = 4\pi \int_0^\infty w_1(b) (1 - w_1(b)) b \, db, \qquad (2)$$

$$\sigma_i^{(+2)} = 2\pi \int_0^\infty w_2^2(b) b \, db.$$
 (3)

Ниже будем предполагать, что $w_1(b)$, $w_2(b)$ могут быть приближенно описаны как вероятности одноэлектронной ионизации из 1*s*-состояния водородоподобных ионов, имеющих заряды ядер z1, z2. При переходе к соответствующим кулоновским единицам вероятности $w_1(b), w_2(b)$ становятся просто вероятностью ионизации водорода. Следует отметить, что, несмотря на простоту такого подхода, зачастую он дает неплохое согласие с экспериментальными данными [4,11,17].

В работе [18] для нахождения сечения ионизации атомов водорода (и водородоподобных ионов) в столкновениях с быстрыми ВЗИ в области параметров задачи $v^2 \gg Z \gtrsim v, v_0 \ll v$ был предложен простой подход. Для дальнейшего удобно привести здесь его основные моменты и результаты. Подход основан на разбиении всей области прицельных параметров $0 \leq b < \infty$ на подобласти: 1) $b \ll v \tau \ (\tau \simeq 1 - {\rm xapaktephoe} \ {\rm atomhoe})$ время); 2) $b \gg Z/v$. В области $b \gg Z/v$, где вероятность ионизации мала, для ее расчета использовался первый порядок теории возмущений по взаимодействию электрона с полем ВЗИ. Для нахождения вероятности ионизации в области $b \ll v\tau$ (где эффективное время столкновения $T \sim b/v$ мало́) использовался нулевой порядок приближения внезапных возмущений [19] по взаимодействию электрона с полем быстрого ВЗИ, причем само это взаимодействие бралось в дипольном приближении. Дипольное разложение для взаимодействия электрона с ВЗИ, законное при b > 1, разумеется, неприменимо при b < 1. Здесь, однако, важно отметить следующее. Сравнение с более точными в этой области b расчетами (например, методом классических траекторий Монте-Карло [20]) показывает, что при $Z \gtrsim v \gg v_0$ использование формально неприменимого дипольного разложения для этого взаимодействия в приближении внезапных возмущений при b < 1 не вносит существенной ошибки в вероятность ионизации и по этой причине в работе [18] нижней границей области 1 было Важно отметить, что для быстрых взято b = 0. частиц с небольшими значениями зарядов (Z « v) такое приближение, как показывает расчет, неприменимо. При $Z/v^2 \ll 1$ области 1 и 2 перекрываются, причем в области перекрытия вероятности ионизации, найденные в обоих приближениях, совпадают. Благодаря этому сечение ионизации, являющееся суммой вкладов от обеих областей, не зависит от выбора "граничной" между ними точки. Таким образом, результаты [17] (и соответственно данной работы, существенно их использующей) применимы при $v^2 \gg Z \gtrsim v \gg v_0$. В [18] для сечения ионизации водородоподобного иона с не слишком большим зарядом ядра (остова) *z_i* (из условия $v_0 \ll v$ следует $z_i \ll v$) было найдено

$$\sigma_i = 8\pi 0.283 \, \frac{Z^2}{v^2 z_i^2} \ln\left(\frac{5v^2}{Zz_i}\right). \tag{4}$$

В работе [21] этот подход был обобщен на случай релятивистских столкновений при $v^2 \gg Z \gtrsim v, v_0 \ll v < c$

$$\sigma_i = 8\pi 0.283 \frac{Z^2}{v^2 z_i^2} \left(\ln\left(\frac{5v^2}{Zz_i}\gamma\right) - \frac{v^2}{2c^2} \right), \qquad (5)$$

где $\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$. Вернемся к сечениям ионизации атомов гелия. Интеграл $4\pi \int_{-\infty}^{\infty} (b) b \, db$, входящий в выражение (2), равен удвоенному сечению ионазации вододородоподобного иона (5), взятому при $z_i = z_1$. При вычислении интегралов $\int_{0}^{\infty} w_{1,2}^2(b) b \, db$, входящих в (2) и (3), поступим следующим образом. В этих интегралах подынтегральное выражение достаточно быстро падает с ростом прицельного параметра уже в области $Zv^{-1}z_{1,2}^{-1} \ll b \ll \gamma v \tau z_{1,2}^{-2}$ $(bw_{1,2}^2 \sim b^{-2})$, где применимо приближение внезапных возмущений. Поэтому при вычислении этих интегралов будем во всей области прицельных параметров $0 \le b < \infty$ использовать вероятности $w_{1,2}(b)$, найденные в этом приближении. Конечно, в области прицельных параметров $b \ge \gamma v \tau z_{1,2}^{-2}$, где поле ВЗИ является для атома не только слабым, но и медленно меняющимся во времени, вероятность ионизации убывает уже не степенным образом, а экспоненциально [22]. Однако и величины $w_{1,2}^2$, рассчитанные в приближении внезапных возмущений, при таких b уже настолько малы, что их использование при расчете этих интегралов во всей области прицельных параметров $0 \le b < \infty$ не вносит заметной ошибки (оцениваемой по порядку величины как $Z^4 \gamma^{-2} v^{-6}$), которой в дальнейшем будем пренебрегать. Используя это приближение, имеем

$$\int_{0}^{\infty} db b w_{1,2}^{2} = \frac{4Z^{2}}{v^{2} z_{1,2}^{2}} \int_{0}^{\infty} \frac{dq}{q^{3}} p^{2}(q),$$
(6)

где величина $\mathbf{q} = 2Z\mathbf{b}/(b^2/v)$ имеет смысл среднего импульса, передаваемого электрону в столкновении с быстрой частицей [18];

$$p(q) = p(\mathbf{q}) = \int d\mathbf{k} |\langle \varphi_{\mathbf{k}} | \exp(-i\mathbf{q}\mathbf{r}) | \varphi_{1s} \rangle|^2$$

— вероятность ионизации атома водорода при внезапной передаче импульса *q* атомному электрону [18] (φ_{1s} , $\varphi_{\mathbf{k}}$ — основное состояние и состояния непрерывного спектра атома водорода соответственно).

Подынтегральное выражение в правой части (6) уже не зависит от Z, v, z_{1,2} и может быть рассчитано численно с учетом явного вида выражения для p(q) (см., например, [23]), что дает

$$\int_{0}^{\infty} db b w_{1,2}^2 = \frac{4Z^2}{v^2 z_{1,2}^2} \, 0.374. \tag{7}$$

С учетом (2), (5) и (7) для сечения однократной ионизации гелия находим

$$\sigma_i^{(1+)} = 16\pi \, \frac{0.283}{z_1^2} \frac{Z^2}{v^2} \left[\ln\left(\frac{\beta_i v^2 \gamma}{Z}\right) - \frac{v^2}{2c^2} \right], \quad (8)$$

где

$$\beta_i = \frac{5}{z_1} \exp\left[-\frac{1}{0.283} \int_0^\infty p^2(q) q^{-3} dq\right] = \frac{1.33}{z_1}$$

Сумма квадратов модулей матричных элементов дипольных переходов из основного состояния в состояния "одноэлектронного" континуума атома гелия, которая в данном подходе определена как $2 \cdot 0.283/z_1^2$, равна 0.489 (см., например, [24]). Из равенства $2 \cdot 0.283/z_1^2 = 0.489$ следует, что $z_1 = 1.11$, и для сечения получаем

$$\sigma_i^{(1+)} = 12.289 \frac{Z^2}{\nu^2} \left(\ln\left(\frac{1.2\nu^2}{Z}\gamma\right) - \frac{\nu^2}{2c^2} \right).$$
(9)

В бете-борновском подходе сечение однократной ионизации гелия описывается следующим выражением (см., например, [24]):

$$\sigma_{BB}^{(1+)} = 12.289 \frac{Z^2}{v^2} \left(\ln(2.08v\gamma) - \frac{v^2}{2c^2} \right).$$
(10)

Сравнение между результатами расчетов по формулам (9) и (10) представлены на рис. 1 и 4.

В ультрарелятивистском пределе $\gamma \gg 1$ результаты, полученные по формулам (9), (10), очень близки друг к другу даже при $Z \sim c$ (рис. 1). Физическая причина такого малого различия между результатами (9) и (10) лежит в следующем. В пределе $\gamma \gg 1$ из-за релятивистского "сплющивания" поля быстрой заряженной частицы вдоль направления ее движения столкновение с ней является для атома внезапным вплоть до очень больших значений прицельного параметра $b \sim c\gamma$, и область $b \gg Z/v$, где



Рис. 1. Сечения однократной ионизации гелия рассчитанные по (9) (сплошная кривая) и (10) (штриховая линия). *Z*: I - 120, 2 - 90; 45 < v < 135.



Рис. 2. Сечения ионизации гелия в столкновениях с ионами U⁺⁹⁰. a — однократная ионизация; b — двойная, c — отношение сечений ионизации $\sigma_i^{(2+)}/\sigma_i^{(1+)}$.

применима теория возмущений, вносит в этом случае подавляющий вклад в сечение однократной ионизации.

На рис. 2, а представлено сравнение между результатами расчета по формуле (9) (сплошная линия) с экспериментальными данными (кружки) из работы [15] по однократной ионизации гелия ионами урана U⁺⁹⁰ (60, 120, 420 Mev/amu) (соответственно v/c = 0.34, 0.46, 0.72). На этом рисунке представлены также данные аппроксимационной формулы Маккензи и Ольсона [8] (штриховая линия). Из-за значительной неопределенности экспериментально измеренных значений сечений можно лишь заключить, что результаты наших расчетов этим данным не противоречат. Выражение (9), как и аппроксимационная формула Маккензи и Ольсена, пред-

сказывает монотонное убывание сечений с ростом скорости столкновения для рассматриваемой в [15] области параметров задачи, что представляется естественным при Z ~ v » v₀, когда перезарядка пренебрежимо мала в сравнении с прямой ионизацией и в то же время релятивистские эффекты невелики ($\gamma \leq 1.4$). Расчет по формуле (9) приводит к значительно бо́льшим величинам сечений однократной ионизации, чем это следует из скейлинга Маккензи и Ольсона, аппроксимирующего результаты численного расчета методом классических траекторий Монте-Карло [9]. Это расхождение вызвано следующими причинами. Согласно классической механике столкновения с достаточно большими прицельными параметрами, при которых (классически рассчитанная) энергия, передаваемая атому, меньше потенциала его ионизации, не вносят заметный вклад в сечение ионизации (вклад области больших прицельных параметров "классически подавлен" [25]). С другой стороны, при квантово-механическом рассмотрении именно эта область прицельных параметров дает основной вклад в сечение ионизации при $v \gg v_0$. Это различие приводит к разным асимптотикам сечений однократной ионизации в области $v \gg v_0$: $\sigma_{\rm cl}'' v^{-2}$ [26]; $\sigma_{\rm q}''({\rm const}_1 + \ln v) v^{-2}(v \gg v_0, Z)$ [14,24], $\sigma_{\rm q} \sim ({\rm const}_2 + \ln(v^2/Z))v^{-2}(Z \sim v \gg v_0)$ [1,18], r.e. pacчет в рамках классической механики должен приводить в рассматриваемой области параметров Z, v к заниженным значениям сечений однократной ионизации [27].

На рис. 3 приведено сравнение результатов наших расчетов с экспериментальными данными (крадраты) [5] по однократной ионизации гелия быстрыми ВЗИ с зарядами $8 \leqslant Z \leqslant 54$ в области энергий столкновения $1 \leqslant E \leqslant 11.4$ MeV/ати, когда релятивистские эффекты в сечении уже практически полностью исчезают.

На рис. 4 данные расчеты по формулам (9) (сплошная кривая), (10) (штриховая) сравниваются с экспериментальными данными из [5] (кружки) по ионизации при фиксированной энергии столкновения E = 3.6 MeV/amu, когда заряд ВЗИ изменяется от Z = 24 до 54. Отметим,



Рис. 3. Сечения однократной ионизации при $v^2/c^2 \ll 1$.



Рис. 4. Сечения однократной ионизации при E = 3.6 MeV/amu и $24 \le Z \le 54$.

что наш расчет воспроизводит экспериментально наблюдающееся отклонение сечений однократной ионизации от зависимости $\sigma_i^{(1+)} \sim Z^2$, которая следует из борновского приближения.

Из (3) и (7) для сечения двукратной ионизации гелия находим

$$\sigma_i^{(2+)} = \frac{9.39}{z_2^2} \frac{Z^2}{v^2}.$$
 (11)

Следуя представлениям обычной теории возмущений, можно было бы ожидать появления в рамках двухступенчатого механизма ионизации зависимости $\sigma_i^{(2+)} \sim Z^4 v^{-4}$ [3,4,15]. Однако в рассматриваемом случае теория возмущений неприменима в области малых прицельных параметров, где вероятность ионизации "насыщается" и очень близка к единице, в то время как используемый здесь подход сохраняет унитарность и дает для вероятности одноэлектронного перехода разумное значение при $Z \gtrsim v \gg v_0$ и в области малых b и мы приходим к качественно иной зависимости $\sigma_i^{(2+)} \sim Z^2 v^{-2}$.

Величина эффективного заряда z_2 , очевидно, должна находиться в пределах 1.69 $< z_2 < 2$, причем эта неопределенность относительно невелика. Мы будем рассматривать z_2 как подгоночный параметр и определим его из сравнения с экспериментальными данными по двойной ионизации гелия быстрыми (но $v^2/c^2 \rightarrow 0$) ВЗИ при $Z \sim v \gg v_0$ [3–5], что дает $z_2 \simeq 2$ и

$$\sigma_i^{(2+)} = 2.35 \frac{Z^2}{v^2}.$$
 (12)

На рис. 2, *b* приведено сравнение сечений, рассчитанных по формуле (12) (сплошная кривая) с экспериментальными данными (кружки) из работы [15] по двойной ионизации гелия ионами урана U⁺⁹⁰ (60, 120, 420 MeV/amu). На рис. 2, *c* представлены результаты

20

эксперимента [15] и расчета по формулам (9) и (12) для отношения сечения двукратной ионизации к сечению однократной (непрерывная линия); здесь же приведены и результаты расчета (штриховая кривая) с использованием эмпирического скейлинга, предложенного в [3] (см., также [5,15]). Как видно из этого рисунка, результаты нашего расчета находятся в хорошем согласии с данными эксперимента по отношению сечений, точность которых оценивается его авторами как 25–30%.

На рис. 5 представлено сравнение расчета по формуле (12) (штриховая) и (14) (сплошная кривая) с экспериментальными данными (кружки) из работ [2–5] по двойной ионизации гелия быстрыми ВЗИ ($8 \le Z \le 54$, 1 MeV/amu $\le E \le 11.4$ MeV/amu). На рис. 6 приведены экспериментальные данные из [2] (кружки) по двойной ионизации гелия при фиксированной энергии столкновения E = 3.6 MeV/amu, когда заряд ВЗИ изменяется от Z = 24 до 54, а также результаты расчета по формуле (12) (штриховая линия) и (14) (слошная). Из этого рисунка видно, что данные расчета по (12) становятся заметно ниже наблюдаемых в эксперименте по мере возрастания отношения Z/v^2 . Например, $(\sigma_{exp}^{(2+)} - \sigma_i^{(2+)})/\sigma_{exp}^{(2+)} \simeq 0.3$ при Z = 54 ($Z/v^2 \simeq 0.38$).

Попытаемся улучшить согласие с экспериментальными данными по сечениям двойной ионизации следующим образом. При выводе выражения для вероятности ионизации в области прицельных параметров, где использовалось приближение внезапных возмущений, мы пренебрегали пространственным сдвигом электрона в течение эффективного времени столкновения $T \sim b(\gamma v)$ (в нулевом порядке приближения внезапных возмущений положение электрона считается "замороженным" в течение столкновения). Этот сдвиг, величину которого можно оценить как $\delta \sim q(b) T(b) \sim Z/v^2$, может быть довольно важен для двойной ионизации, поскольку область прицельных параметров $b \ll vz_2^{-2}$, где приближение внезапных возмущений применимо, дает подавля-



Рис. 5. Сечение двукратной ионизации при $v^2/c^2 \ll 1$.



Рис. 6. Сечение двукратной ионизации при $E = 3.6 \,\text{MeV}/\text{amu}$ и $24 \leq Z \leq 54$.

ющий вклад именно в сечение двойной ионизации (для однократной ионизации это не так из-за члена $(1 - w_1)$ и того, что значительный вклад в интеграл $\int_{0}^{\infty} db \, bw_1(b)$ вносится областью прицельных параметров $b \sim v z_1^{-2}$, где приближение внезапных возмущений неприменимо).

В работе [28] было показано, что при $b \ll v$ волновая функция атомного электрона после столкновения может быть приближенно представлена как

$$\varphi_{1s}(\mathbf{r}-\boldsymbol{\delta})\exp(i\mathbf{q}\mathbf{r}),$$

где $\varphi_{1s}(\mathbf{r})$ — волновая функция исходного состояния, $\boldsymbol{\delta} \sim Z \mathbf{b} / v^2 b$.

Для применимости используемого в данной работе подхода необходимо, чтобы пространственный сдвиг δ был мал в сравнении с характерным атомным размером $r_0 \sim 1$ и мы можем записать

$$arphi_{1s}(\mathbf{r}-oldsymbol{\delta})\simeq arphi_{1s}(\mathbf{r})-oldsymbol{\delta} \, rac{\partial arphi_{1s}(\mathbf{r})}{\partial oldsymbol{
ho}}\simeq arphi_{1s}(\mathbf{r})-\delta \, rac{\partial arphi_{1s}(\mathbf{r})}{\partial
ho}.$$

Используя для качественной оценки производной приближенное соотношение¹ $\partial \varphi_{1s} / \partial \rho \sim (-\varphi_{1s}/r_0)$ [29] и учитывая выражения (3), (6), имеем

$$\sigma_i^{(2+)} \simeq \frac{9.39}{z_2^2} \frac{Z^2}{\nu^2} (1 + \alpha_1 Z/\nu^2), \tag{13}$$

где $\alpha_1 > 0$ — не зависящая от Z и v величина.

Есть еще одна возможность для увеличения сечения за счет пространственного сдвига δ . Когда (при сдвиге) изменяется положение электронных волновых пакетов (без существенного изменения их исходной формы [28])

¹ В рамках используемого подхода величина δ может быть оценена только качественно. Поэтому точное вычисление $\partial \varphi_{1s} / \partial \rho$ (и соответствующих интегралов по переменным **r**, **b**) не имеет смысла.

может также измениться экранировка ядра гелия для каждого из атомных электронов. При движении в свободном атоме электроны "стремятся" быть на наибольшем возможном расстоянии друг от друга из-за их взаимного отталкивания. В течение короткого времени взаимодействия T(b) сильное поле ВЗИ сдвигает электронные пакеты от их исходных положений в приблизительно одинаковом направлении. Это приводит к уменьшению отношения среднего межэлектронного расстояния к среднему расстоянию от электронов до ядра гелия и соответственно электроны увеличивают экранировку ядра атома друг для друга. Таким образом, можно предположить, что эффективный заряд атомного остова должен убывать при сдвигании электронов. Рассматривая эффективный заряд z2 как функцию этого сдвига (т.е. как функцию отношения Z/v^2) и используя для малых Z/v^2 простое разложение

$$z_2^{-2} \simeq z_2^{-2}(0)(1 + \alpha_2 Z/v^2),$$

где $\alpha_2 > 0$ не зависит от Z, v и $z_2(0) \simeq z_2(v^{-1})$ $\simeq z_2(Z = v) \simeq 2$, из (12) и (13) получаем

$$\sigma_i^{(2+)} \simeq 2.35 \frac{Z^2}{v^2} (1 + \alpha Z/v^2),$$
 (14)

где $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$.

Отметим, что учет в сечении члена порядка Z^3/v^4 все еще возможен в рамках используемого приближения, когда отброшен член порядка Z^4/v^6 , который гораздо меньше, чем Z^3/v^4 при $Z/v^2 \ll 1$. Сравнение с экспериментальными данными из работ [2–5] приводит к $\alpha = 0.5$. Результаты расчета по формуле (14) приведены на рис. 5, 6 (сплошные кривые). Для рассматриваемых на рис. 2 параметров столкновения Z, v результаты для сечений, полученных по (12) и (14), практически совпадают.

Во многих работах [3,5,15] большое внимание уделяется изучению отношения сечений $R = \sigma_i^{(2+)} / \sigma_i^{(1+)}$. Для этого отношения из (9) и (14) имеем

$$R = 0.19 \left(1 + 0.5Z/v^2\right) \left(\ln\left(\frac{1.2v^2}{Z}\gamma\right) - \frac{v^2}{2c^2} \right)^{-1}.$$
 (15)

Авторы эксперимента [15] указывали на то, что их данные по R как функции от v/Z для реакций с участием U⁺⁹⁰ (60, 120, 420 MeV/amu) не ложатся на "универсальную" кривую. На наш взгляд, эти данные из [15] не стоят особняком по сравнению с другими данными по ионизации гелия быстрыми ионами с высокими значениями заряда (это, в частности, следует из рис. 8, b работы [5] тех же авторов, что и [15]). "Универсальная" кривая для R, предложенная в [3] для относительно небольших значений зарядов налетающих частиц, не является, по нашему мнению, таковой для столкновений с участием ионов с высокими значениями заряда. Кроме того, нам представляется, что в области параметров столкновения $Z \gtrsim v \gg v_0$ более естественно

откладывать *R* как функцию величины v^2/Z (а не v/Z, во всяком случае пока лоренцевский фактор γ не слишком велик $\gamma \ll v^2/Z$), памятуя известный скейлинг для сечений ионизации быстрыми (но нерелятивистскими) ВЗИ $\sigma/Z = f(v^2/Z)$ [1]. В такой шкале все известные нам данные по *R* для быстрых ВЗИ неплохо ложатся на кривую, описываемую выражением (15).

Заключение

Нами предложены простые формулы для сечения одно- и двукратной ионизации атомов гелия при столкновениях с быстрыми ионами с очень высокими значениями зарядов, которые применимы в достаточно широкой области параметров столкновения: $v^2 \gg Z \gtrsim v$, $v_0 \ll v < c$. К настоящему времени эти сечения довольно систематически изучены экспериментально при $v^2/c^2 \ll 1$. В то же время при $Z \sim v \sim c$ имеются лишь единичные экспериментальные данные (и то лишь при небольших значениях γ). Пр нашему мнению, определенный интерес представляло бы выполнение систематических исследований сечений ионизации гелия тяжелыми ионами в области релятивистских скоростей столкновения, когда γ значительно превышает единицу.

Список литературы

- [1] Пресняков Л.П., Шевелько В.П., Янев Р.К. Элементарные процессы с участием многозарядных ионов. М.: Энергоатомиздат, 1986. 200 с.
- [2] Berg H. Doctor Thesis. Universitat Frankfurt, 1993.
- [3] Knudsen H., Andersen L.H., Hvelplund P. et al. // J. Phys. 1984. Vol. B17. P. 3545–3564.
- [4] McGuire J.H., Mueller A., Schuch B. et al. // Phys. Rev. 1987. Vol. A35. P. 2479–2483.
- [5] Berg H., Ullrich J., Bernstein E. et al. // J. Phys. 1992.
 Vol. B25. P. 3655–3670.
- [6] Janev R.K., Presnyakov L.P. // J. Phys. 1980. Vol. B13. P. 4233–4244.
- [7] Janev R.K. // Phys. Lett. 1981. Vol. A83. P. 5-7.
- [8] McKenzie M.L., Olson R.E. // Phys. Rev. 1987. Vol. A35.
 P. 2863–2868.
- [9] Salin A. // Phys. Rev. 1987. Vol. A36. P. 5471-5475.
- [10] Reading J.F., Ford A.L. // Phys. Rev. Lett. 1987. Vol. 58. N 6.
 P. 543–546. J. Phys. 1987. Vol. B20. P. 3747–3769.
- [11] Nikolaev V.S., Sidorovich V.A. // Nucl. Instr. Meth. 1989.
 Vol. B36. P. 239–248.
- [12] Fainstein P.D., Ponce V.H., Rivarola R.D. // J. Phys. 1991.
 Vol. B24. P. 3091–3135.
- [13] Presnyakova L.P., Tawara H., Tolstikhina I.Yu., Uskov D.B. // J. Phys. 1995. B28. P. 785–793.
- [14] Мотт Н., Месси Г. Теория атомных столкновений. М.: Наука, 1969. 756 с.
- Berg H., DuBois M.D., Jagutzki O. et al. // Phys. Rev. 1992.
 Vol. A46. P. 5539–5544.
- [16] Ullrich J., Moshammer R., Berg H. et al. // Phys. Rev. Lett. 1993. Vol. 71. N 11. P. 1697–1700.
- [17] McGuire J.H. // Adv. At. Mol. and Opt. Phys. 1992. Vol. 29. P. 217–323.

- [18] Войткив А.Б., Коваль А.В. // ЖТФ. 1994. Т. 64. Вып. 3. С. 188–191.
- [19] Дыхне А.М., Юдин Г.Л. // УФН. 1978. Т. 125. С. 377-412.
- [20] Reinhold C.O., Falcon C.A., Miraglia J.E. // J. Phys. 1987. Vol. B20. P. 3737–3745.
- [21] Войткив А.Б., Матвеев В.И. // ЖТФ. Т. 65. Вып. 1. С. 12– 18.
- [22] Думан Е.Л., Меншиков Л.И., Смирнов Б.М. // ЖЭТФ. 1979. Т. 76. С. 516–527.
- [23] Holt A.R. // J. Phys. 1969. Vol. B2. P. 1209-1214.
- [24] Inokuti M. // Rev. Mod. Phys. 1971. Vol. 43. P. 297–332. Ibid. 1978. Vol. 50. P. 23–56.
- [25] Reinhold C., Burgdorfer J. // J. Phys. 1993. Vol. B26. P. 3101–3122.
- [26] Thomson J.J. // Phil. Mag. 1912. Vol. 23. P. 449–453.
- [27] Willis S.L., Peach G., McDowell M.R.C., Banerji J. // J. Phys. 1985. Vol. B18. P. 3921–3932.
- [28] Voitkiv A.B., Pazdzersky V.A. // J. Phys. 1988. Vol. B21. P. 3369–3374.
- [29] Мигдал А.Б., Крайнов В.П. Приближенные методы в квантовой механике. М.: Наука, 1966. 230 с.